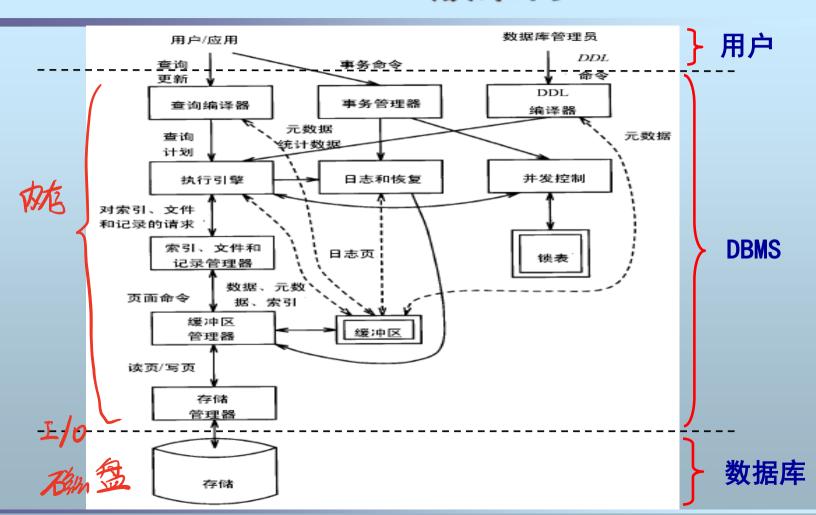
Data Storage

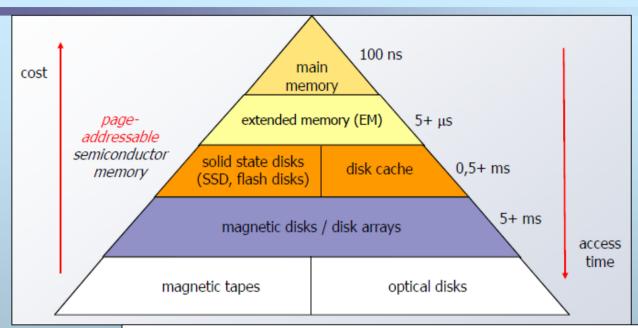
DBMS一般架构

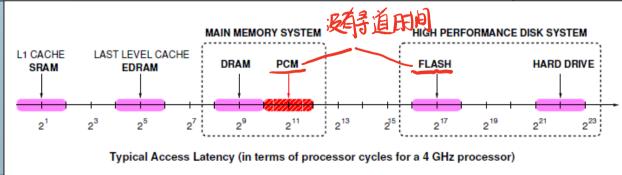


主要内容

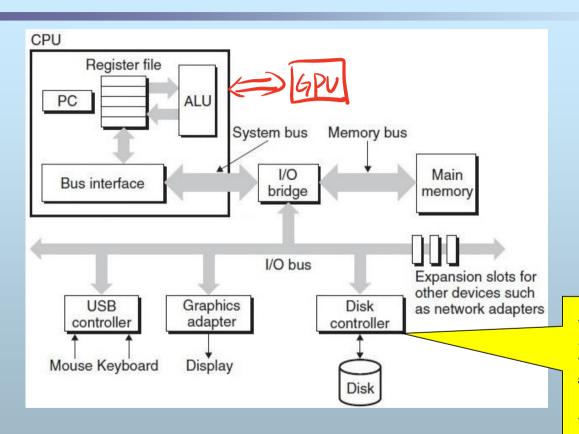
- 存储器结构(Disk Structure)
- 磁盘块存取时间(Block Access Time)
- 磁盘例子: Megatron747
- 磁盘存取优化(Optimization)
- ■新型存储

一、存储器结构



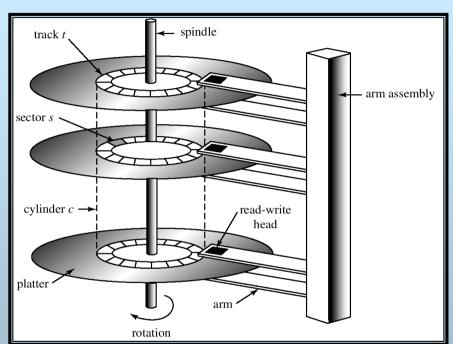


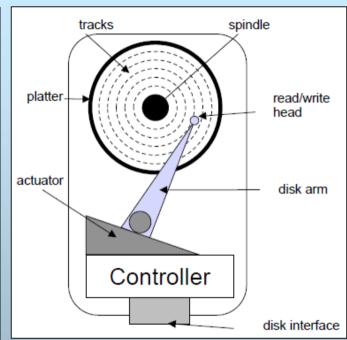
1、计算机系统结构



磁盘驱动器与计算机的接口。控制磁盘臂实现对磁盘(扇区)的 读写

2、典型磁盘结构 号道(电机部)



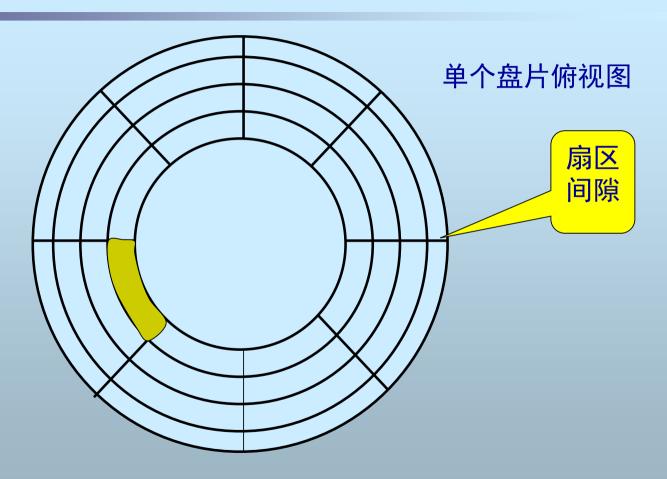


- ■几个术语
 - 盘片platter, 盘面 surface, 磁头 R/W head, 磁道 track, 柱面 cylinder, 扇区 sector

2、典型磁盘结构

0号道

图读取



二、磁盘块存取时间

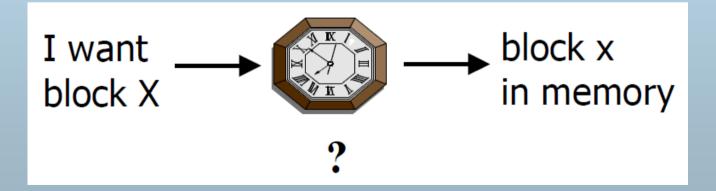
- 块(Block)
- 块(Block) 等这性能一般用 2/0 次数可加坡数衡量, tme 作为辅助,到如果变的状态影响。OS或DBMS进行磁盘数据存取的最小逻辑单元,
 - 由若干连续扇区构成
 - 块是DBMS中数据存取的最小单元
 - 。扇区是磁盘中数据存储的最小单元

oracle. DB2 预块

一个数据库的新盘块大小星确定的4岁时8岁

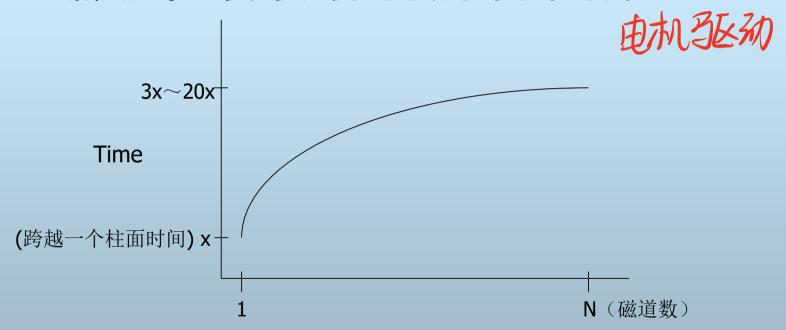
1、读块时间

- 磁盘块读取时间
 - ●从"发出块存取请求"到"块位于主存"的时间
 - =寻道时间S+旋转延迟R+传输时间T+其它延迟



2、寻道时间(Seek Time)

■ 磁头定位到所要的柱面所花费的时间



Cylinders Traveled

3、平均寻道时间

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N}\text{SEEKTIME }(i\rightarrow j)$$

N(N-1)

S一般在10 ms~40 ms之间 取决于减分

4、旋转延迟(Rotation Latency)

- 磁盘转动到块的第一个扇区到达磁头所需的 时间
- 平均时间为旋转1/2周所费的时间

一个7200RPM的磁盘

平均旋转延迟 R≈4.17 ms

5、传输延迟(Transfer Time)

- 块的扇区及其间隙旋转通过磁头所需的时间
- 如果磁道大约有100 000字节,约10ms转一周,则每秒可从磁盘读取约10M字节,一个4K字节的块传输时间小于0.5ms

6、其它延迟

- CPU请求I/O的时间 (CPU time to issue I/O)
- 争用磁盘控制器时间 (Contention for controller)
- 争用总线和主存的时间 (Contention for bus, memory)

典型情况:0

7、如何读下一块?

- CASE 1: 下一块在同一柱面上
 - 。旋转延迟十传输时间十其它(忽略)
- CASE 2: 不在一个柱面上
 - 寻道土旋转+传输+其它

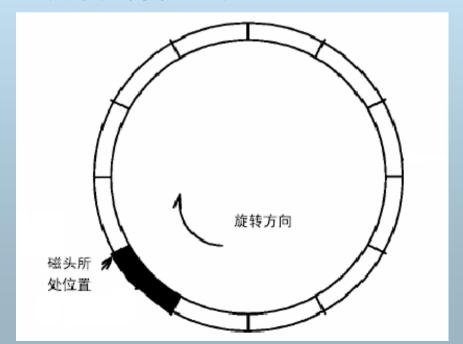
Random I/0

Sequential I/O

For a 4KB block Random $I/0 \approx 20$ ms Sequential $I/0 \approx 1$ ms

8、写块

- ■与读块类似
- 如果需要校验块是否正确写入,则需要加上一次旋转时间和一次块传输时间



9、块修改

- 将块读入主存
- 在主存中完成修改
- ■将块重新写入磁盘

10、块地址

- ■物理设备号
- 柱面号
- 盘面号(或磁头号)
- ■扇区号

三、磁盘例子: Megatron747

- ■参数
 - 3.5 inch
 - 3840 RPM
 - 8 surfaces
 - 8192 tracks/surface
 - 256 sectors/track
 - 512 bytes/sector
- Megatron 747大小
 - 8*8192*256*512 = 2³³ = 8 GB

1、Megatron 747参数

- 寻道时间 (最大): 17.4 ms
- 磁头启动停止1 ms, 每移动500个柱面需1ms
- 1 block = 4 KB = 8 sectors
- 块之间的间隙占块的10%大小
- 每磁道大小=(256/8)*4 KB=128 KB=32块
- 每柱面大小=8*128KB=1 MB

随机读块时间 = 块数 × 平均存取时间

顺序滨块明的=七平均到上土地等上土块数人七色物

十KX七最将直

2、Megatron747存取时间

- 3840 RPM → 1/64 秒/转 = 15.625 ms
- 读取一个磁道时间=15.625 ms, 其中
 - 用于磁道数据的时间=15.625 * 0.9=14.0625 ms
 - 用于扇区间隙的时间=15.625*0.1=1.5625 ms
- 读取一个块的时间=15.625/32-1.5625/256≈ 0.482 ms
 - 读取数据的时间=15.625/32 * 0.9 ≈ 0.439 ms

2、Megatron747存取时间

■ OS或DBMS随机读取一块的最大时间

• T=S+R+T =
$$17.4 + 15.625 + 0.482 \approx 33.507 \text{ ms}$$

- 最小时间: 0.482 ms
- 平均时间 = 七平均野道十 七维特

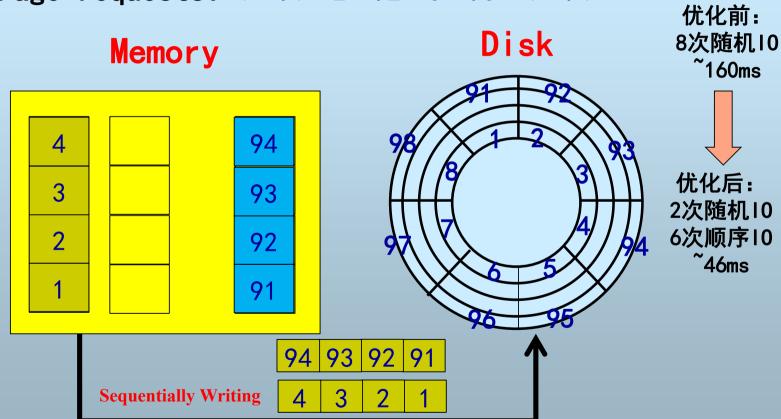
• T=S+R+T
=6.5 + 7.8125 + 0.482
$$\approx$$
 14.8 ms

四、磁盘存取优化

- 按柱面组织数据
 - 减少平均寻道时间
- 磁盘调度算法
 - 如电梯算法 (Elevator Algorithm)
- 磁盘阵列(Disk Arrays)
- 磁盘镜像(Disk Mirrors)
- Random IO to Sequential IO
- 预取(Pre-fetch)和缓冲(Buffering)

1. Random IO to Sequential IO

Page requests: 1-91-2-92-3-93-4-94.....



1、预取/缓冲

- 双缓冲(Double Buffering)
- 单缓冲(Single Buffering)

```
例:一个文件由一系列块构成: B1, B2, ···
```

设有一程序,按下面顺序处理数据:

- 1、处理B1
- 2、处理B2
- 3、处理B3

• • • • •

2、单缓冲处理策略

- (1) 将B1读入缓冲区
- (2) 在缓冲区中处理B1中的数据
- (3) 将B2读入缓冲区
- (4) 处理缓冲区中的B2数据

. . .

3、单缓冲处理分析

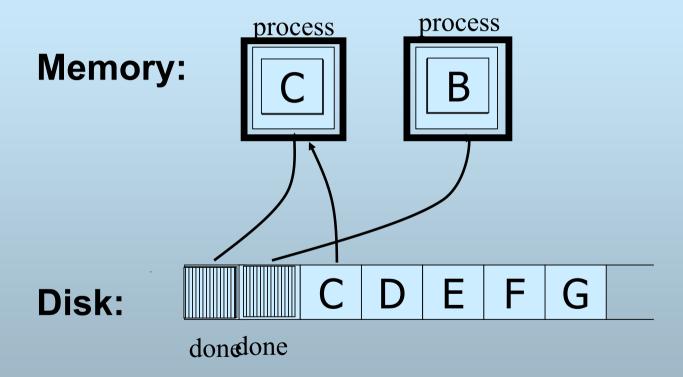
设 P = 在缓冲区中处理一块的时间

R = 将一块读入缓冲区的时间

n = 块数

单缓冲处理时间 = n(P+R)

4、双缓冲



4、双缓冲分析

P = Processing time/blockR = IO time/blockn = # blocks

- 双缓冲处理时间=R+nP(P>=R)=nR+P(R>=P)
- 单缓冲处理时间=n(R + P)

5、缓冲的缺点

- ■主存代价
- ■缓冲区管理
- 一致性维护

6、块大小选择

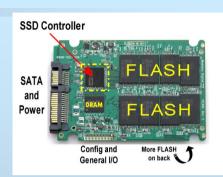
- ■大块
 - I/O次数 ↓
 - 可能读入大量无用数据
 - 每次I/O要花费更多时间
- 趋势
 - 大块

五、新型存储

- 计算机系统性能依赖于
 - 处理器的数据计算能力
 - 存储层次向处理器传输数据的能力
- 随着多\众核、多线程技术的发展,传统存储器件构成的存储 层次面临的<mark>存储墙</mark>问题愈发严重
- 新型存储器件包括:闪存、相变存储器、磁阻式存储、电阻式存储器、忆阻器等等。具备一个共同特点:非易失性
 - 优点: 高存储密度、低功耗、无机械延迟、存取速度快、便携、抗震 、低噪音等
 - 缺点: 读写性能不对称、读写次数有限、可靠性不高等

1、闪存 Flash Memory

- 闪存的工业化程度最高
 - SSD (solid state drive)
 - 内存芯片+控制器+FTL (WL, LBA-PBA, GC)
- (NAND) 闪存的特点
 - 读写不对称
 - ◆ 写慢读快
 - 写前擦除: 异位更新、块擦除操作
 - 寿命有限: 块擦除次数有限
 - ◆ SLC (约10万次擦写)
 - ◆ MLC (小于1万次)
 - ◆ TLC (小于1000次)
 - 按页读写
 - ◆ E.g., 1 page = 2 KB
 - 按块擦除
 - ♦ E.g., 1 block = 64 pages



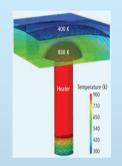
	Access time		
Media	Read	Write	Erase
Magnetic [†]	12.7 ms	13.7 ms	N/A
Disk	(2 KB)	(2 KB)	
NAND	$80 \mu \mathrm{s}$	$200~\mu s$	1.5 ms
Flash [‡]	(2 KB)	(2 KB)	(128 KB)

	SSD	HDD
读取速度	快	慢
写入速度	快	慢
耗电量	低	较高
稳定性	高	低
耐严苛环境度	优	劣
耐久性与可靠性	优	劣
抗震性	佳	差
存储容量	较低	高
成本	高	低
尺寸重量	优	劣

2、相变存储器 Phase Change Memory

PCM

- 起源于20世纪60年代
- 电阻式非易失性半导体存储器



以硫族化物材料作为存储介质,利用相变材料在 不同结晶状态时呈现出显著的电阻值差异性来实 现数据存储

2、相变存储器

PCM vs. Flash

	DRAM	PCM	NAND Flash
Page size	64B	64B	4KB
Page read latency	20-50ns	~ 50ns	~ 25 μs
Page write latency	20-50ns	~ 1 µs	~ 500 µs
Write bandwidth	~GB/s	50-100 MB/s	5-40 MB/s
	per die	per die	per die
Erase latency	N/A	N/A	~ 2 ms
Endurance	∞	10 ⁶ - 10 ⁸	10 ⁴ - 10 ⁵
Read energy	0.8 J/GB	1 J/GB	1.5 J/GB [28]
Write energy	1.2 J/GB	6 J/GB	17.5 J/GB [28]
Idle power	~100 mW/GB	~1 mW/GB	1–10 mW/GB
Density	$_{1}\times$	2 – 4×	4×

2、相变存储器

PCM vs. DRAM

	DRAM	PCM	NAND Flash
Page size	64B	64B	4KB
Page read latency	20-50ns	~ 50ns	~ 25 μs
Page write latency	20-50ns	~ 1 µs	~ 500 μs
Write bandwidth	~GB/s	50-100 MB/s	5-40 MB/s
	per die	per die	per die
Erase latency	N/A	N/A	~ 2 ms
Endurance	∞	10 ⁶ - 10 ⁸	10 ⁴ - 10 ⁵
Read energy	0.8 J/GB	1 J/GB	1.5 J/GB [28]
Write energy	1.2 J/GB	6 J/GB	17.5 J/GB [28]
Idle power	~100 mW/GB	~1 mW/GB	1–10 mW/GB
Density	$_{1} imes$	2 – 4×	4×

小 结

- 存储器结构(Disk Structure)
 - 柱面、磁道、扇区、块
- 磁盘块存取时间(Block Access Time)
 - 寻道时间、旋转延迟、传输时间
 - 块存取时间分析
- 磁盘例子: Megatron747
- 磁盘存取优化(Optimization)
- 新型存储